

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

#3

10/070653

**PRIORITY
DOCUMENT**SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

REC'D 24 NOV 2000

WIPO

PCT

DE 00/02918

EJU

**Prioritätsbescheinigung über die Einreichung
einer Patentanmeldung****Aktenzeichen:**

199 42 879.4

Anmeldetag:

8. September 1999

Anmelder/Inhaber:

ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart/DE

Bezeichnung:Halbleiterelement und Verfahren zur Herstellung des
Halbleiterbauelements**IPC:**

H 01 L 29/38



Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 22. September 2000
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag

Dzierzon



01.09.99 Gz/Ep

5

ROBERT BOSCH GMBH, 70442 Stuttgart

10

Halbleiterelement und Verfahren zur Herstellung des
Halbleiterbauelements

Stand der Technik

15

Die Erfindung geht aus von einem Halbleiterbauelement bzw. einem Verfahren zur Herstellung nach der Gattung der unabhängigen Ansprüche. Aus der DE 36 33 161 A1 ist bereits eine Gleichrichterdiode bekannt, bei der neben einer einfachen pn-Schichtenfolge weitere Layoutmaßnahmen vorgesehen sind zur Erzielung eines verbesserten Erholungsverhaltens (engl. „recovery behavior“) bei Kommutierung.

20

Vorteile der Erfindung

30

Die erfindungsgemäße Anordnung beziehungsweise das erfindungsgemäße Verfahren mit den kennzeichnenden Merkmalen der unabhängigen Ansprüche haben demgegenüber den Vorteil, ohne zusätzliche Layoutmaßnahmen die Bereitstellung von Halbleiterbauelementen mit hohen Taktfrequenzen und damit verbunden kleinen Schaltzeiten zu ermöglichen, ohne daß der Ausräumstrom beim Umpolen in Sperrrichtung steil abfällt. Dadurch wird in einfacher Weise sichergestellt, daß trotz kurzer Schaltzeiten keine steilen Stromabrisse aufgrund immer vorhandener Streuinduktivitäten zu hohen Störspannungsspitzen führen; somit wird es möglich, in

35

einfacher Weise schnell schaltende Bauelemente in Kraftfahrzeugen für Gleichrichteranordnungen einzusetzen, bei denen ansonsten solche Spannungsspitzen beispielsweise den Radioempfang stören würden. Darüber hinaus gewährleistet die erfindungsgemäße Diode neben der kurzen Schaltzeit und einem sanften Abfall des Ausräumstroms eine niedrige Flußspannung und somit niedrige Wärmeverluste bei Polung der am Bauelement anliegenden Spannung in Durchlaßrichtung.

Durch die in den abhängigen Ansprüchen aufgeführten Maßnahmen sind vorteilhafte Weiterbildungen und Verbesserungen der in den unabhängigen Ansprüchen angegebenen Bauelemente bzw. Verfahren möglich.

Besonders vorteilhaft ist, Gräben mit rechteckförmigem Querschnitt vorzusehen, um mit möglichst wenig Gräben das gewünschte Verhältnis zwischen Bereichen unterschiedlicher Mittelzonendicke herzustellen.

Werden die Randbereiche durch keine Vertiefungen aufweisende Bereiche gebildet, so ist das Bauelement unempfindlich gegen Beschädigungen und Verunreinigungen an der Chipkante.

Weitere Vorteile ergeben sich durch die in der Beschreibung genannten Merkmale.

Zeichnung

Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in der Zeichnung dargestellt und in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert. Figur 1 zeigt eine Gleichrichterdiode, Figur 2 ein Diagramm, Figur 3a eine Querschnittsseitenansicht einer Diode, Figur 3b eine Draufsicht auf eine Diode.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

5 Figur 1 zeigt eine Halbleiterdiode mit einer schwach n-dotierten Mittelzone 2, die auf ihrer Oberseite mit einer stark p-dotierten Schicht 1 und auf ihrer Unterseite mit einer stark n-dotierten Schicht 3 bedeckt ist. Die Schichten 1 und 3 sind mit (nicht eingezeichneten) Metallisierungen
10 versehen.

Die Schichten 1 und 2 bilden an ihrer gemeinsamen Grenzfläche den pn-Übergang der Halbleiterdiode.

15 Figur 2 zeigt ein Diagramm mit einer Zeitachse 5 und einer Ordinatenachse 6. Dargestellt ist ein sinusförmiger Spannungsverlauf 7, der an den Schichten 1 und 3 der Halbleiterdiode der Figur 1 angelegt ist. In Durchlaßrichtung folgt der Strom durch die Diode im wesentlichen dem
20 Spannungsverlauf 7, also der positiven Halbwelle des Spannungsverlaufs 7 in der linken Hälfte des Diagramms. Wechselt die Spannung 7 das Vorzeichen, so wird die Diode in Sperrrichtung gepolt, der Strom durch die Diode folgt noch eine kurze Zeit, die so genannte Schaltzeit 9, ungefähr dem Spannungsverlauf, bis er in die Ausräumstromkurve 8 übergeht.

Beim Umschalten von Fluß- in Sperrrichtung müssen in die Mittelzone indizierte Ladungsträger ausgeräumt werden, bevor
30 die Diode in der Lage ist, die Sperrspannung aufzunehmen. Die hierzu notwendige Zeit ist die Schaltzeit 9.

In der Querschnittsseitenansicht der Figur 3a ist eine Schichtenfolge 10, 20, 30 dargestellt, die eine Diode
35 bildet. Die Schicht 10 ist n-dotiert und entspricht der

Dotierung eines bei der Herstellung dieses Bauelements verwendeten schwach n-dotierten Substrats. Auf der Unterseite der Schicht 10 ist eine stark n-dotierte Schicht 20 aufgebracht, die ihrerseits an ihrer Außenseite mit einer (nicht eingezeichneten) Metallisierung versehen ist. Auf der Oberseite der Schicht 10 ist eine stark p-dotierte Schicht 30 aufgebracht. In die Oberseite der Diode sind Gräben 60 eingebracht, die erste Bereiche 40 und zweite Bereiche 50 definieren. In den ersten Bereichen 40 ist die Schicht 10 dicker ausgelegt als in den zweiten Bereichen 50, während die Schicht 30 in beiden Bereichen ungefähr die gleiche Dicke aufweist. Die Gräben 60 befinden sich im Innenbereich 70 der Diode, während der restliche Bereich der Diode, der Randbereich, durch erste Bereiche 40 gebildet wird. Auf der Oberfläche 80 der Diode ist wiederum eine (nicht eingezeichnete) Metallisierung aufgebracht. In der Draufsicht in Figur 3b ist mit der Querschnittslinie 100 die Stelle markiert, für die in Figur 1a die Querschnittsseitenansicht abgebildet ist. Auf der Oberfläche 80 sind parallel zu den Außenkanten der Diode eingebrachte Gräben 60 ersichtlich, wobei die Gräben sich kreuzen und jeweils zwei parallele Gräben parallel zu jeder Außenkante des Bauelements angeordnet sind. Die Tiefe der Gräben 60 beträgt beispielsweise zirka 70 Mikrometer, die Dicke der Schicht 10 im Bereich 40 zirka 80 Mikrometer und die Dicke der Schicht 10 im Bereich 50 zirka 10 Mikrometer. Die Dicken der Schichten 20 und 30 betragen jeweils zirka 60 Mikrometer. Die Dotierkonzentration in der Schicht 10 beträgt beispielsweise zirka $4 \cdot 10^{14} \text{ cm}^{-3}$, die Dotierkonzentrationen an den Oberflächen der Schichten 20 und 30 (die Oberfläche der Schicht 30 ist in Figur 3a mit Bezugszeichen 80 versehen) jeweils zirka $7 \cdot 10^{19} \text{ cm}^{-3}$.

Der Bereich 40 stellt einen hochsperrenden Diodenteil mit breiter Mittelzone 10 dar (Durchbruchspannung ≥ 200 Volt),

Anzahl der Gräben pro Chip bestimmt sich aus den festgelegten Flächenproportionen von Bereich 40 zu Bereich 50 und aus der gewählten Grabenbreite.

- 5 Das erfindungsgemäße Verfahren kommt zur Bereitstellung solcher Bauelemente ohne zusätzliche Diffusionsschichten bzw. ohne zusätzliche Layoutmaßnahmen aus. Es handelt sich um ein großserientaugliches, teilweise, zumindest was das Einbringen der Gräben betrifft, außerhalb des Reinraumes durchführbares Verfahren.
- 10

01.09.99 Gz/Ep

5

ROBERT BOSCH GMBH, 70442 Stuttgart

10

Ansprüche

15

1. Halbleiterbauelement mit einer ersten Schicht (10) eines ersten Leitfähigkeitstyps mit einer Oberseite und einer Unterseite, wobei die Oberseite von einer zweiten Schicht (30) eines zweiten Leitfähigkeitstyps bedeckt und auf der Unterseite eine dritte Schicht (20) angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Schicht infolge mindestens einer in die Oberseite eingebrachten Vertiefung (60) Bereiche (40, 50) unterschiedlicher Dicke aufweist.

20

2. Halbleiterbauelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die mindestens eine Vertiefung als Graben mit rechteckförmigem Querschnitt ausgebildet ist.

30

3. Halbleiterbauelement nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens ein Viertel der Unterseite keine Vertiefungen aufweisende erste Bereiche (40) begrenzt.

4. Halbleiterbauelement nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens die halbe Fläche der Unterseite Vertiefungen aufweisende zweite Bereiche (50) begrenzt.

5. Halbleiterbauelement nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß ein Randbereich durch keine Vertiefungen aufweisende zweite Bereiche (40) gebildet wird.

5 6. Halbleiterbauelement nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die zweite Schicht (30) stark dotiert ist.

10 7. Halbleiterbauelement nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die dritte Schicht (20) vom ersten Leitfähigkeitstyp und stark dotiert ist.

15 8. Halbleiterbauelement nach Anspruch 6 und 7, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Schicht und die dritte Schicht mit Metallisierungen versehen sind.

20 9. Verfahren zur Herstellung von Halbleiterbauelementen, dadurch gekennzeichnet, daß in einem Wafer eines ersten Leitfähigkeitstyps Vertiefungen eingebracht werden, in einem weiteren Schritt beide Seiten des Wafers mit Dotieratomen belegt werden und ein Diffusionsprozeß erfolgt, wobei in einem weiteren Schritt eine Zerteilung des Wafers in einzelne Chips erfolgt, so daß jeder Chip in seinem Innenbereich (70) mindestens eine Vertiefung (60) aufweist.

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Vertiefungen als Gräben mit rechteckförmigem Querschnitt ausgebildet werden.

30 11. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, daß vor dem Zerteilen des Wafers auf beide Seiten des Wafers Metallschichten aufgebracht werden.

12. Verfahren nach Anspruch 9, 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, daß die Zerteilung in Bereichen (40) des Wafers erfolgt, in denen keine Vertiefungen eingebracht worden sind.

5 13. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß bei der Belegung der Oberseite ein Dotierstoff eines zweiten Leitfähigkeitstyps verwendet wird.

10 14. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß bei der Belegung der Unterseite ein Dotierstoff des ersten Leitfähigkeitstyps verwendet wird.

15 15. Verfahren nach Anspruch 11, 13 und 14, dadurch gekennzeichnet, daß die Metallschichten auf die erste und die dritte Schicht aufgebracht werden.

01.09.99 Gz/Ep

5

ROBERT BOSCH GMBH, 70442 Stuttgart

10

Halbleiterelement und Verfahren zur Herstellung des
Halbleiterbauelements

Zusammenfassung

15

20

Es wird ein Halbleiterbauelement und ein Verfahren zu seiner Herstellung vorgeschlagen, das die Bereitstellung eines Schaltelements für hohe Schaltfrequenzen ermöglicht, ohne daß immer vorhandene Streuinduktivitäten zu hohen Störspannungsspitzen führen. Dazu sind in die Oberfläche des Wafers eingebrachte Gräben vorgesehen, die zu einer Mittelzone (10) mit lateral variabler Dicke führt. Erste Bereiche (40) dieser Mittelzone (10) gewährleisten sanften Ausräumstromabfall, zweite Bereiche (50) kurze Schaltzeiten und niedrige Flußspannung.

30

(Figur 3a)

1
2
3

Fig.1

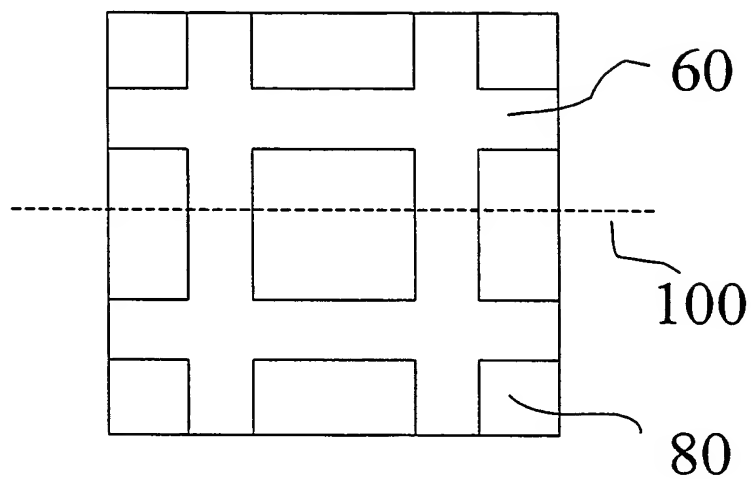


Fig. 3b